

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ ГАСАНЛИ Ш.М.

1. Гасанли Ш.М., Лагунова Т.С., Емельяненко О.В., Ксаманлы Ф.П. Определение концентрации примесей по эф. Холла и подвижности дырок в кристаллах p-GaAs легированных цинком Ж.Физика и техника Полупроводников (ФТП) т.5, вып.10, 1971
2. Гасанли Ш.М., Лагунова Т.С., Емельяненко О.В, Наследов Д.Н. О природе отрицательного магнитосопротивления в p-GaAs Ж. Физика и техника Полупроводников(ФТП) т.6, вып.1, 1971
3. Гасанли Ш.М., Емельяненко О.В, Наследов Д.Н Особенности переноса носителей в кристаллах p-GaAs с глубокими примесями. Ж. Физика и техника Полупроводников (ФТП) т.6, вып.10, 1972
4. Гасанли Ш.М., Ксаманлы Ф.П. Отрицательное магнито-сопротивление в p-GaAs. Тезисы докладов на Всесоюзной конференции физики соединений A^3B^5 Ленинград, 1978
5. Гасанли Ш.М., Аллазов М. Р. Гамидов Р. Г. Влияние некоторых добавок на спексаемость варисторов на основе оксида цинка В сбор. Статей Респуб. Конференции «Физико-механический анализ и неорганич. материаловедение», Баку , 1995
6. Гасанли Ш.М., Т. С. Лагунова Д. Н. Наследов Тезисы Всесоюзной конференции по электрическим и оптическим свойствам кристаллов A^3B^5 и сложных соединений $A^2B^4C_2^5$ «Ылым», Ашхабад , 1971
7. Гасанли Ш.М., М.И. Сергинов М. Рудь Всесоюзной конференции по электрическим и оптическим свойствам кристаллов A^3B^5 и сложных соединений $A^2B^4C_2^5$ «Ылым», Ашхабад , 1971
8. Г. Б. Семушкин, Гасанли Ш.М. Изучение причин определяющих особенностей свойств диэлектрика и границы раздела Д/П в тонкопленочных МДП-структурах, а также временное изменение этих свойств с целью отработки технологии МДП-приборов с заданными параметрами ЛПИ им. М.И. Калинина т.№9631 ,1974 20
9. А.Н. Благодаров, Гасанли Ш.М. Определение исходных данных разработки технологии и формирование границы раздела Д/П с минимальной плотностью дефектов для П/П A^3B^5 ЛПИ им. М.И. Калинина т.№9751 ,1976 13
10. А.Н. Благодаров, Гасанли Ш.М. Исследование пленочных и кристаллических диэлектриков и границы раздела полупроводник - диэлектрик ЛПИ им. М.И. Калинина т.№2129 ,1977 23
11. А.Н. Благодаров, Гасанли Ш.М Изучение электропроводности и поляризации тонкопленочных систем с неорганическим и органическим диэлектриком ЛПИ им. М.И. Калинина т.№4015 ,1979 16
12. Гасанли Ш.М., О.Г. Казаков Исследование электрофизических параметров полупроводниковых приборов Гос. Регистрация.№01830012472,Т. №928, БИТМ, Брянск 1984, 91
13. Гасанли Ш.М, А.К. Стрельцов В.И. Самсонов Исследование и повышение прочности полупроводниковых пластин и структур прочности полупроводниковых пластин и структур на основе кремния на основе кремния Гос. регистрация.№018600780942,Т. №988, БИТМ, Брянск 1986 64
14. Гасанли Ш.М, А.К. Стрельцов Физика твердого тела и поверхностных явлений. Теоретические и экспериментальное изучение физических и механических свойств твердых тел Припр. БИТМ, г. Брянск 1986 84

15. Гасанли Ш.М, А.К. Стрельцов Физика твердого тела и поверхностных явлений. Теоретические и экспериментальное изучение физических и механических свойств твердых тел и МДП-структур. БИТМ, г. Брянск 1989, 80с.
16. Гасанли Ш.М, А.К. Стрельцов В.И. Самсонов Исследование возможности отбраковки потенциально ненадежных кремниевых структур Припр. Гос. Регистрация. №018600790562, Т. №927, БИТМ, Брянск 1988, 54с
17. Гасанли Ш.М Электропроводность металлов и полупроводников (область слабых электрических полей) Припр. БИТМ, г. Брянск 1983, 24с.
18. Гасанли Ш.М Электропроводность металлов и полупроводников (область сильных электрических полей). Припр. БИТМ, г. Брянск 1983, 25 с.
19. Гасанли Ш.М Контактные явления(металл-проводник). Припр. БИТМ, г. Брянск 1983, 18 с.
20. Гасанли Ш.М Уравнение состояние идеального газа Припр. БИТМ, г. Брянск 1983, 13с.
21. Гасанли Ш.М., Михайлов Б.Н., Мороз Г.Н. Подвижность дырок в инверсионных слоях МДП-структур /Тезисы докладов на Всесоюзном совещании по физике поверхностных явлений в полупроводниках, Киев, 1977 с.71.
22. Бахышов А.Э., Гасанли Ш.М., Михайлов Б.Н., Мороз Г.Н. Исследование проводимости и концентрации носителей тока в инверсионных слоях МОП-структур на основе Si//«Ученые записки» АГУ, серия физ.- мат. наук 1978, №5, стр.43-46.
23. Гасанли Ш.М., Бахышов А.Э., Мусаева Г.В.. Схема для измерения электрических параметров высокоомных полупроводников// «Ученые записки» АГУ, серия физ.-мат. наук 1973 №22, стр.63-65.
24. Гасанли Ш.М., Гасанлы Н.М., Гусейнов Р.Э. Электрические свойства кристаллов с глубокими примесными уровнями.// «Ученые записки» АГУ, серия физ.-мат. наук 1975, №3, стр. 80-91.
25. Гасанли Ш.М., Бахышов А.Э., Гасанлы Н.М. Исследование электрических свойств кристаллов GaAs легированных хромом и никелем//. «Ученые записки» АГУ, серия физ.-мат. наук 1975 №22, стр.96-101.
26. Гасанли Ш.М., Голубев В.В., Кунин В.Я. Подвижность дырок и плотность состояний на границе Si-SiO₂.//Известия ВУЗОВ, Физика, 1980, №12,стр.44-48.
27. Гасанли Ш.М., Брюхно Н.А., И.Н.Комаров. Причины боя структур с поликремниевой подложкой и их прочность. 1984, Москва ЦПН Электроника// Микроэлектроника, стр.3-5.
28. Гасанли Ш.М. Проводимость и подвижность электронов в инверсионных каналах Д/МДП-структур// Известия вузов, Физика, 1983, №11, с.64-67.
29. Гасанли Ш.М., Брюхно Н.А., Стрельцов А.К., Казаков О.Г. Использование анизотропии прочности кремниевых структур для уменьшения боя пластин /Тезисы докладов, Рязань, 1984, с.78.
30. Брюхно Н.А., Гасанли Ш.М., Стрельцов А.К., Устройство для изготовления образцов с косым шлифом. 1985, А.С. №171692.
31. Гасанли Ш.М., Брюхно Н.А., Стрельцов А.К., Устройство для изготовления образцов с косым шлифом травления ЦНТИИ, Брянск, 1985,стр.3-5.
32. Брюхно Н.А., Гасанли Ш.М., Способ упрочнения кремниевых пластин /Тезисы докладов, надежность ИС на основе КСДИ, Киев 1986, с.86.
33. Гасанли Ш.М., Сериков Н.М., Казаков О.Г. Установка для определения прочности кремниевых структур и пластин ЦНТИИ, Брянск, 1986 .стр.4-6.
34. Гасанли Ш.М., Стрельцов А.К. Динамическая прочность полупроводниковых материалов ЦНТИИ, Брянск, 1986.стр.3.-5.

35. Кобазева З.Н., Гасанли Ш.М., Влияние анизотропного травления на надежность мощных кремниевых транзисторов //Микро-электроника . 1986, Вып. 7, стр.2-5.
36. Брюхно Н.А. Гасанли Ш.М., Кобазева З.Н. Способ упрочнения поликристаллических подложек КСДИ//Микроэлектроника . 1986,Вып. 5, стр.2-4.
37. Гасанли Ш.М., Сериков Н.М., Батрак С.Ф. Установка для определения механической прочности полупроводниковых материалов ЦНТИИ, Брянск, 1987.стр.2-4.
38. Гасанли Ш.М., Палечек Д.М., Чуванкина Н. Устройство для контроля надежности кремниевых пластин ЦНТИИ, Брянск, 1988,стр.5-7.
39. Кобазева З.Н, Гасанли Ш.М., Неразрушающий контроль качества механического геттера// Микроэлектроника . 1989 ,Вып.1 (297), стр.56-58.
40. Брюхно Н.А., Гасанли Ш.М., V-образные канавки как концентраторы механических напряжений на кремниевых кристаллах //Микроэлектроника. 1989, Вып.1(297), стр. 52-55.
41. Бурьба В.В., Брюхно Н.А., Гасанли Ш.М. Способ изготовления кремниевых структур с диэлектрической изоляцией А.С. №1436773 1990
42. Брюхно Н.А. Гасанли Ш.М., Способ изготовления пластин кремния А.С. №1547617 1990
43. Гасанли Ш.М., Брюхно Н.А., Стрельцов А.К., Влияние возможности анизотропного травления на механическую прочность монокристаллического кремния//Электронная промышленность, 1990, №2 , стр.6-10.
44. Гасанли Ш.М., Аббасов С.А., Мамедов Ш.В. Влияние процессов металлизации и скрайбирования на величину механической прочности кремниевых интегральных схем/ Международная конференция «Приборы с отрицательным сопротивлением и интегральные преобразователи на их основе». Баку, 1991.с.98.
45. Гасанли Ш.М., Аббасов С.А., Мамедов Ш.В. Взаимосвязь между морфологией поверхности и механической прочностью кремниевых пластин/Международная конференция Приборы с отрицательным сопротивлением и интегральные преобразователи на их основе.Баку, 1991, с.78.
46. Gasanly Sh.M., Gasanly N.M.. Influence of anisotropic etching the mechanical strength of single crystal silicon wafers// Physics stat. sol(a). 1991, 127, p.127-131.
47. Aslanov R.B., Gasanly Sh.M., The mechanical strength of silicon plate after anisotropig etching / The 5th World on Heat Treatment and surface Enginerig, IFHT 95 “ Material and Manufacturing Processes Iran, Isfagan,1995 , p.105.
48. Gasanly Sh.M., Bayramov Ch.B. The effect of the plazmochenical etching on the strength characteristics of the silicon plates./ The 5th World on Heat Treatment and surface Enginerig, IFHT 95 “ Material and Manufacturing Processes , Iran, Isfagan, 1995 , p.85.
49. Gasanly Sh.M., Guseynov E.K. The influence of surface on the mechanical strength of silicon wafers// Turkish journal of Physics 1995 , vol.19, nom.4, p.644-648.
50. Гасанли Ш.М., Гусейнов Э.К.Поведение подвижности носителей в инверсионном канале МДП-структур// Жур. Тех. Физики, 1995, №12 стр.139-144.
51. Gasanly Sh.M., Aslanov R.B To the question of working characteristics rise of MDS-transistors on the base of silicon /Tabriz Abstract of the first gathering on applied physics research and its role in the country’s industry.1997, p.11.
52. Gasanly Sh.M., Gumbatov S.S. The effect of annealing, putting of phoaphor- silicat glass and field treatment on the parameters of silicon MDS-transistors/ The 6th international symposium on advanced materials Islamabad, Pakistan .19-23 September 1999, p.56.
53. Gasanly Sh.M., About of behavior of the charge carriers in inversion chaannels of MIS-structures on the base./Second international school-conference:” Physical problems in material science of semiconductors” Chernovitsii –Ukraina 1999 p.198.

54. Гасанли Ш.М., Алиев Ф.И. Поведение подвижности носителей в инверсионных каналах МДП-структур // Журн. "Fisika" N2, 2000, с.6-10.
55. Bidadi H., Hasanli Sh.M., Mazidi M. Influence of high-temperature on the electrophysical and mechanical properties of silicon plates and MIS-transistors. / Актуальные проблемы физики 2-ая Республиканская конференция Баку 30-31 октябрь 2001 с. 71.
56. Видади Г., Гасанли Ш.М. Влияние плазмохимического травления на прочностные характеристики кремниевых пластин в сбор. Статей Респуб. Конференции «Физико-механический анализ и неорган. материаловедение», Баку, 2001 стр.251-256.
57. Bidadi H., Sobhanian S., Hasanli Sh.M., Study of the distorted layer structure of silicon wafers by the method of plasma-chemical etching, after mechanical machining processes. // Iranian Journal of science and technology, Transaction Aa, 2004, v.28. N A2, p.350-358.
58. Гасанли Ш.М., Бидади Х., Мазиди М. Особенности механической деформации кремниевых пластин и структур на их основе после различных технологических операций // Журнал «Бильги», Физика, математика, наука о земле №2, 2002, стр.17-20.
59. Bidadi H., Sobhanian S., Hasanli Sh.M., Mazidi M The peculiarities of mechanical bending of silicon wafers after diverse manufacturing operations. / 4th International conference on low dimensional structures and devices 2002 08-13 December., Fortaleza-Ceara, Brazil, ps.35.
60. Bidadi H., Sobhanian S., Hasanli Sh.M. Conduction carriers current in crystals of arsenide of gallium with impurities of chrome, manganese, cobalt and nickel. Iranian annual physical society conference August 2002, Zanjan p18-21.
61. Bidadi H., Mazidi M., Hasanli Sh.M. Influence of various technology processes on the bending velocity of silicon plates and structures. Iranian annual physical society conference August 2002, Zanjan p18-21.
62. Bidadi H., Sobhanian S., Hasanli Sh.M., The peculiarities of mechanical bending of silicon wafers after diverse manufacturing operations // Microelectronics Journal (Elsevier) N5, 2003, p.514-519.
63. Bidadi H., Sobhanian S., Hasanli Sh.M. The peculiarities of mechanical bending of silicon wafers after diverse manufacturing operations // Society of Manufacturing Engineers. USA, Dearbon, 2003, EEO3-231, p.1-8.
64. Hasanli Sh.M. Definitions mechanical strains of silicon plates after various technological operations // Society of Manufacturing Engineers. USA, Dearbon, 2003, EEO3-280, p.1-6.
65. Hasanli Sh.M. Influence of the infrigend statum on quantity of mechanical strength // Society of Manufacturing Engineers. USA, Dearbon, 2003, TPO3PB399, p.1-7.
66. Hasanli Sh.M., Mursakulov N.A. A role about dislocations at processes of the mechanical bending of silicon wafers // Ж. Fizika, 2003 т.9, с.3-6.
67. Гасанли Ш.М. Неразрушающий метод контроля качества механического геттера / Актуальные проблемы физики 3-ая Республиканская конференция Баку февраль, 2004, с.104-105.
68. Гасанли Ш.М. Определение остаточного напряжения кремниевых пластин после различных технологических операций // Журнал «Бильги», Физика, математика, наука о земле №4, 2003, стр.8-13.
69. Гасанли Ш.М. Влияние процесса термообработки на механические характеристики кремниевых пластин / Ж. "XABARLAR" 2004, XXIV, №5, с.Т8.
70. Ghorbanpor H., Bidadi H., Hasanli Sh.M. Studying of a sag in silicon plates after various technological processes. В сбор. Статей IX Респуб. Конференции «Физико-механический анализ и неорган. материаловедение», Баку, 2004, стр.178-185.
71. Sh.M. Azizova, A.S. Bondyakov, Sh.M. Hasanli, R.N. Mechtizadeh. Temperature dependence of electrophysical characteristics of varistors on basis ZnO. Second

- international. Conference on technical and physical problems in power Engineering (TPE), 6-8 September 2004, Tabriz-Iran, p.447.
72. Sh.M. Hasanli, R.N. Mechtizadeh, E.K. Huseynov, S.A. Seyedzadeh Sabonchu. Vibro-acoustic diagnostics of rotary type machines and Mechanisms. Second international. Conference on technical and physical problems in power Engineering (TPE), 6-8 September 2004, Tabriz-Iran, p.450.
 73. А.М. Гашимов, Ш.М. Гасанли., Р.Н. Мехтизаде, Х.Б. Байрамов А.С, Бондяков А.С. Нелинейные резисторы (варисторы) на основе оксида цинка с примесями. «Физиканын актуал проблемляри» 111 Республика елми конгрессинин материаллары, февраль 2004, Баку, стр.97.
 74. Гасанли Ш.М., Мехтизаде Р.Н. Влияние полевых обработок на параметры МДП-структур/The International conference on relaxation phenomena in solids (RPS-21). Voronezh, Russia, 2004, 5-8 October, Abstracts, p.51.
 75. Гашимов А.М., Гурбанов К.Б., Гасанли Ш.М., Мехтизаде Р.Н. Влияние термообработок на электрические и механические характеристики структур на основе кремния. Труды международной конференции. «Fizika-2005», Баку, с.546-548.
 76. Гасанли Ш.М. Влияние полевых обработок на подвижность и проводимость носителей тока в инверсионных каналах МДП-структур. Труды международной конференции. «Fizika-2005», Баку, с.606-609.
 77. Hasimov A.M., Hasanli Sh.M. Influence the heat treatment on the mechanical characteristics of silicon plates. Ж. «Fizika», 2004, №4 S.71-72.
 78. Bidadi H, Azizova Sh.M., Gasanli Sh.M., Mehtizadeh R.N., Allazov M.R., Bondyakov A.S. Electrophysical characteristics of composited varistors. Fifth international conference on composite science and technology. February, 1-3 2005, p.430-435. American University of Sharjah, United Arab Emirates.
 79. Həsənli Ş.M., Həşimov A.M., Mehdizadə R.N., Əzizova Ş.M., Bayramov X.B., Allazov M.P. Varistor. Patent № a 2005 0059. Həşimov A.M., Qurbanov K.B., Həsənli Ş.M., Əzizova Ş.M., Bayramov X.B. Patent . Nazik təbəqəli kompozit varistorun hazırlanma üsulu. Patent, № a 2005 01111